

放射測温方法及び放射測温システム

【技術分野】

機械・加工、その他（計測）

【特許番号/公開番号】

WO2009/081748

【利用分野・適用製品】

ガラス、セラミック、金属その他、熱電対の使用が困難な測定対象の表面温度測定。
アルミニウムのような、光沢のある金属への放射測温法の適用。

【ライセンス情報】

実施許諾 【可】 権利譲渡 【否】

【目的】

基板上の薄膜の温度を非接触状態において正確に測定する。

【技術概要】

シリコンウエハ温度を校正するためのハイブリッド表面温度センサと放射率が p -偏光輝度を利用した場合、 55° の角度で、温度、酸化膜厚、抵抗率に関わらず一定となる”放射率不变条件”の発見に基づく放射測温法。

【効果】

本発明は、例えば半導体製造プロセスにおいて基板上に成膜される薄膜の表面のその場における温度測定（in-situ temperature measurement）を非接触状態により行う放射測温方法及びその方法を実施するための放射測温システムに適用して有効である。

【特記事項・図面・その他】

